

广东协铨微电子科技有限公司

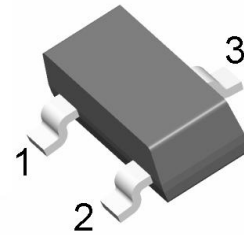
General Purpose Transistors 通用三极管

XCTA56

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特点

Complementary to FHTA06 与 FHTA06 互补

SOT-23



PIN ASSIGNMENT 引脚说明

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V _{CEO}	-80	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V _{CBO}	-80	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V _{EBO}	-4.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集电极电流-连续	I _C	-500	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	P _c	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T _j , T _{stg}	150, -55 ~150	℃

DEVICE MARKING 打标

XCTA56=2GM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25℃)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-80V, I _E =0	—		-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	I _{CEO}	V _{CE} =-60V, I _C =0	—		-0.1	μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	V _{(BR)CEO}	I _C =-1.0mA	-80	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	V _{(BR)CBO}	I _C =-1.0 mA	-80	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	V _{(BR)EBO}	I _E =-100μA	-4.0	—	—	V
DC Current Gain 直流电流增益	h _{FE} (1)	V _{CE} =-1V, I _C =-10mA	100	—	—	—
	h _{FE} (2)	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA	100	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _C =-100mA, I _B =-10mA	—	—	0.25	V
Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压	V _{BE}	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA	—	—	-1.2	V
Transition Frequency 特征频率	f _T	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA, f=100MHz	50	—	—	MHz